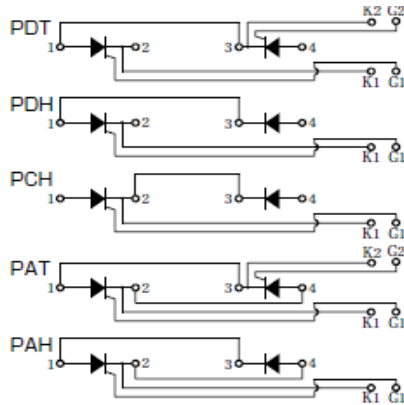


THYRISTOR

200 A Avg 1600 Volts

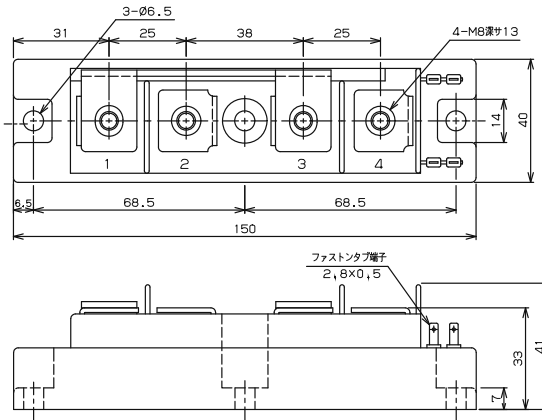
PDT20016 PDH20016
PCH20016 PAT20016
PAH20016

■回路図 CIRCUIT



■外形寸法図 OUTLINE DRAWING

Dimension: [mm]



■最大定格 Maximum Ratings

項目 Parameter	記号 Symbol	耐圧クラス Grade	単位 Unit
		PDT/PDH/PCH/PAT/PAH20016	
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DRM}	1600	V
非くり返しピークオフ電圧 Non Repetitive Peak Off-State Voltage	V_{DSM}	1700	V
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	1600	V
非くり返しピーク逆電圧 Non Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RSM}	1700	V

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit		
平均オン電流 Average On-State Current	$I_{O(AV)}$	商用周波数 180° 通電 $T_c = 75^\circ C$ Half Sine Wave	200	A		
実効オン電流 RMS On-State Current	I_{TRMS}		314	A		
サージオン電流 Surge On-State Current	I_{ISM}	50Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A		
電流二乗時間積 I Squared t	I^2t	2~10ms	80000	$A^2 s$		
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	$V_D = 2/3 V_{DRM}$, $I_{TM} = 2 \cdot I_O$, $T_j = 125^\circ C$ $I_G = 300mA$, $di/dt = 0.2A/\mu s$	100	$A/\mu s$		
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P_{GM}		5	W		
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	$P_{G(AV)}$		1	W		
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I_{GM}		2	A		
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V_{GM}		10	V		
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V_{RGM}		5	V		
動作接合温度範囲 Operating Junction Temperature Range	T_{jw}		-40 ~ +125	$^\circ C$		
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T_{stg}		-40 ~ +125	$^\circ C$		
絶縁耐圧 Isolation Voltage	V_{iso}	端子-ベース間, AC 1分間 Terminal to Base, AC 1min.	2500	V		
締付トルク Mounting Torque	ベース部 Mounting	F	サマロノパウンド 塗布 Greased	M6	2.5 ~ 3.5	$N \cdot m$
	主端子部 Terminal		M8	9.0 ~ 10.0	$N \cdot m$	

■電気的特性 Electrical Characteristics

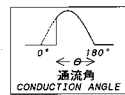
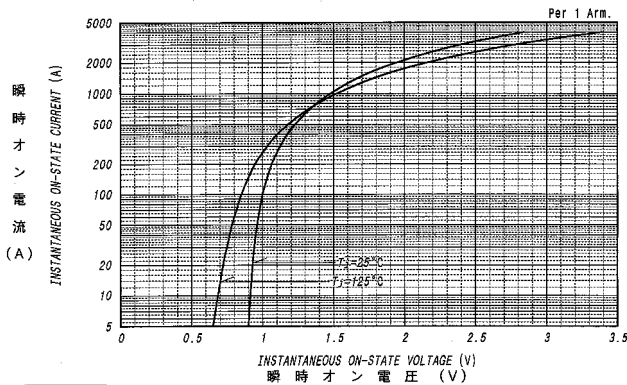
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min.	標準 Typ.	最大 Max.	
ピークオフ電流 Peak Off-State Current	IDM	Tj=125°C, VDM=VDRM			80	mA
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	IRM	Tj=125°C, VRM=VRRM			80	mA
ピークオン電圧 Peak On-State Voltage	VTM	Tj=25°C, ITM=600A			1.28	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	IGT	VD=6V, IT=1A	Tj= -40°C		300	mA
			Tj= 25°C		150	mA
			Tj= 125°C		80	mA
			Tj= -40°C		5	V
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	VGT	VD=6V, IT=1A	Tj= -40°C		5	V
			Tj= 25°C		3	V
			Tj= 125°C		2	V
			Tj= 125°C		2	V
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	VGD	Tj=125°C, VD=2/3VDRM	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage	dv/dt	Tj=125°C, VD=2/3VDRM	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	tq	Tj=125°C, ITM=Io, VD=2/3VDRM dv/dt=20V/μs, VR=100V, -di/dt=20A/μs		100		μs
ターンオン時間 Turn-On Time	tgt			6		μs
遅れ時間 Delay Time	td	Tj=25°C, VD=2/3VDRM Ig=300mA, dig/dt=0.2A/μs		2		μs
立上がり時間 Rise Time	tr			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	IL	Tj=25°C			150	mA
保持電流 Holding Current	IH	Tj=25°C			100	mA
熱抵抗 Thermal Resistance	Rth(j-c)	接合部-ケース間 Junction to Case			0.2	°C/W
接触熱抵抗 Thermal Resistance	Rth(c-f)	ケース-フィン間, サーマルコンパウンド塗布 Case to Fin, Greased			0.1	°C/W

質量…約480g
Approximate Weight

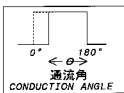
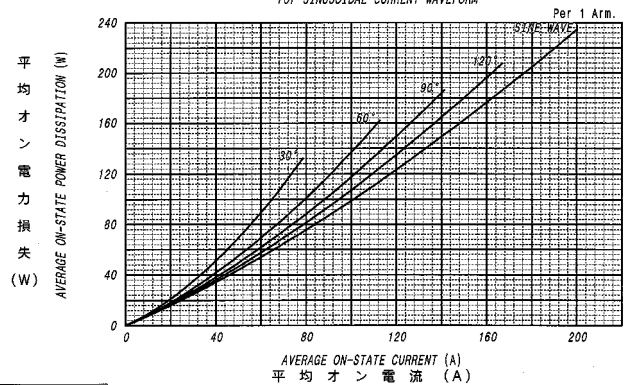
1アーム当りの値 Value Per 1 Arm.

■定格・特性曲線

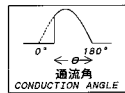
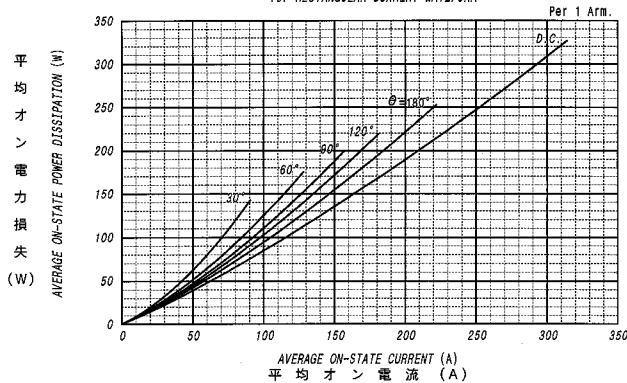
オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE



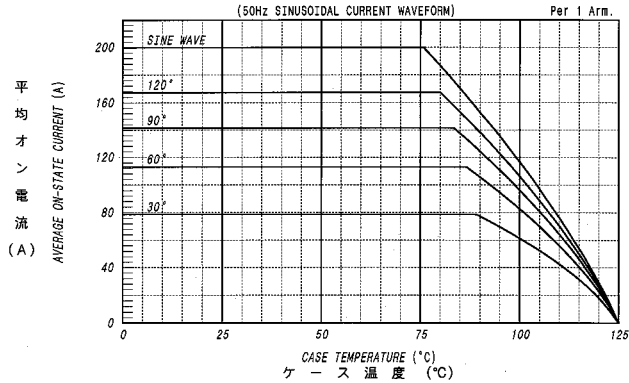
平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
for SINUSOIDAL CURRENT WAVEFORM

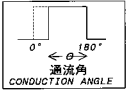


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION
for RECTANGULAR CURRENT WAVEFORM

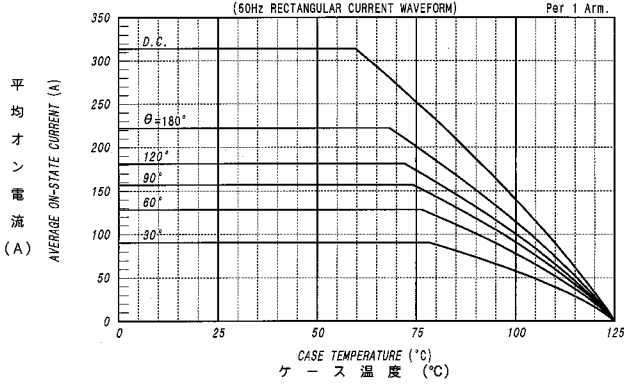


平均オン電流-ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE





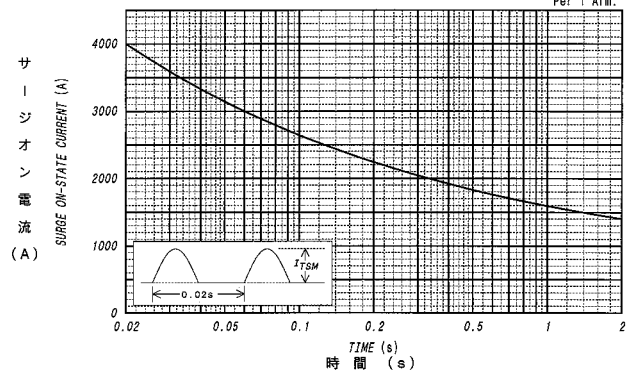
平均オン電流 - ケース温度定格
AVERAGE ON-STATE CURRENT VS. CASE TEMPERATURE



ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS

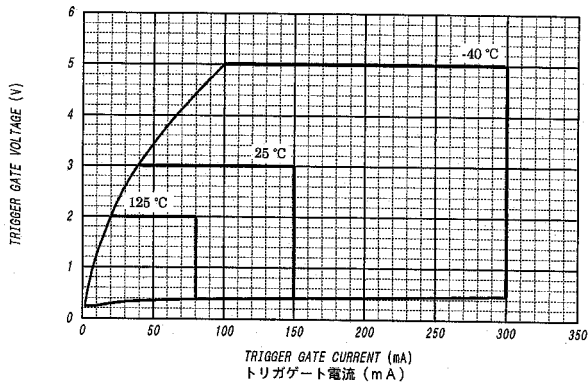
サージオン電流定格
SURGE CURRENT RATINGS

f=60Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=125°C

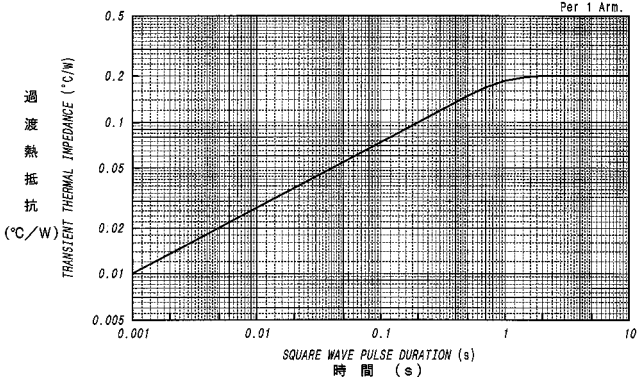


ゲート定格
GATE RATINGS

トリガゲート電圧 (V)



過渡熱抵抗特性
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
Junction to Case



ゲート電圧 (V)

